

Содержание

● Электронные свойства полупроводников

Сардарлы Р.М., Салманов Ф.Т., Алиева Н.А., Аббаслы Р.М.

Импедансные характеристики γ -облученных твердых растворов $(\text{TiGaSe}_2)_{1-x}(\text{TlInS}_2)_x$ 511

Аванесян В.Т., Жаркой А.Б., Ракина А.В.

Особенности переноса заряда в легированных слоях сульфида цинка в низкочастотном переменном электрическом поле 519

Нифтиев Н.Н., Мамедов Ф.М., Мурадов М.Б.

Электропроводность FeGaInSe_4 на переменном токе . . . 523

● Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Гусейналиев М.Г., Ясинова С.Н., Джалилли Д.Н., Мехтиева С.И.

Оптические свойства и критические точки наноструктурированных тонких пленок PbSe 527

Priya V.L., Prithivikumaran N.

Influence of Ni-Doping in ZnO Thin Films Coated on Porous Silicon Substrates and ZnO/PS Based Hetero-junction Diodes 532

● Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Галашев А.Е., Воробьев А.С.

Электронные свойства пленок силицена, подвергнутых нейтронному легированию 533

Dubrovskii V.G., Reznik R.R., Kryzhanovskaya N.V., Shtrom I.V., Ubyivovk E.D., Soshnikov I.P., Cirilin G.E.

MBE-Grown $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ Nanowires with 50% Composition 542

● Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники

Амасев Д.В., Михалевич В.Г., Тамеев А.Р., Саитов Ш.Р., Казанский А.Г.

Формирование двухфазной структуры в металлоорганическом перовските $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ 543

● Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Шутаев В.А., Гребенщикова Е.А., Сидоров В.Г., Компан М.Е., Яковлев Ю.П.

Влияние водорода на импеданс структур Pd/оксид/InP . . 547

● Углеродные системы

Рутыков Е.В., Афанасьева Е.Ю., Галль Н.Р.

Транспортные процессы с участием атомов углерода между поверхностью и объемом родия при образовании и разрушении графена 552

● Физика полупроводниковых приборов

Асадчиков В.Е., Дьячкова И.Г., Золотов Д.А., Чуховский Ф.Н., Никитина Е.В.

Коррекция характеристик кремниевых фотодиодов путем применения ионной имплантации 557

Марков Л.К., Смирнова И.П., Кукушкин М.В., Павлюченко А.С.

Модификация рельефа n -поверхности AlGaInN -светодиодов изменением состава газовой смеси при реактивном ионном травлении 564

Жуков А.Е., Крыжановская Н.В., Моисеев Э.И., Кулагина М.М., Минтаиров С.А., Калужный Н.А., Надточий А.М., Максимов М.В.

Предельная температура генерации микродисковых лазеров 570

Калыгина В.М., Алмаев А.В., Новиков В.А., Петрова Ю.С.

Солнечно-слепые детекторы УФ-излучения на основе пленок $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ 575

Калядин А.Е., Штельмах К.Ф., Аруев П.Н., Забродский В.В., Карабешкин К.В., Шек Е.И., Соболев Н.А.

Кремниевые светодиоды с люминесценцией (113) дефектов 580

● Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Laifi J., Bchethnia A.

Impact of Carrier Gas on the GaN Layers Properties Grown on (001) and (11 \bar{n}) GaAs Substrates by AP-MOVPE: Comparative Study 585